平成26年度 大阪大学基礎工学部編入学試験 [エレクトロニクスコース専門科目] 試験問題

受	験	番	号	志望	望学科	3 — :	ス
						学	科
						٦-	ース

[エレ専門-1]

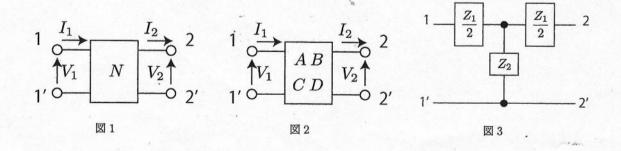
問題 1

2端子対回路網の影像パラメータを用いてフィルタの解析を行う。影像パラメータは 2個の影像インピーダンスと影像伝達定数の 3 つのパラメータからなる。影像インピーダンスは図 1 のように与えられた 2端子対回路網に対して、端子対 22'にインピーダンス Z_{i2} を接続したとき、端子対 11'から見たインピーダンスが Z_{i1} であり、端子対 11'にインピーダンス Z_{i1} を接続したとき、端子対 22'から見たインピーダンスが Z_{i2} を満たす Z_{i1} 、である。また、影像伝達定数 θ は端子対 22'にインピーダンス Z_{i2} を接続したとき、

$$e^{ heta}=\sqrt{rac{V_1I_1}{V_2I_2}}$$

で定められる値である.虚数単位はj,角周波数は ω で正弦波定常状態とし,以下の設問に答えよ.

- (1) Z_{i1} および Z_{i2} を,図 2 のように与えられる 2 端子対回路網の 4 端子定数 A,B,C,D で表せ.
- (2) フィルタを図 3 で与えられる対称 T 形回路で構築した。この回路の $\cosh\theta$ を求めよ。 $\cosh\theta = \sqrt{AD}$, $\sinh\theta = \sqrt{BC}$ であることを用いてもよい。
- (3) $\theta=\alpha+j\beta$ (α は影像減衰定数, β は影像位相定数。 α , β は実数)とおくと, $\alpha=0$ および $\alpha>0$ の とき,11' に入力した電力の大きさ $|I_1V_1|$ と 22' に出力される電力の大きさ $|I_2V_2|$ の間に成り立つ大小 関係をそれぞれ表せ
- (4) 図 3 の回路において $\alpha=0$ となるために必要な Z_1 , Z_2 が満たすべき条件を求めよ。なお, Z_1 および Z_2 は純虚数とする。 $\cosh(\alpha+j\beta)=\cosh\alpha\cos\beta+j\sinh\alpha\sin\beta$ を用いてもよい.
- (5) 図 3 の回路において Z_1 を 2 mH のインダクタ, Z_2 を 2 nF のキャパシタとしたとき, しゃ断周波数 ω (ヒント: $\alpha=0$ と $\alpha\neq 0$ の境界に等しい) および $\alpha\neq 0$ となるときの $\cosh\alpha$ の値を求めよ. さらに問 (3) の結果も利用し, この回路が低域通過フィルタ, 高域通過フィルタ, 帯域消去フィルタ, 帯域通過フィルタのいずれかを記せ.



平成26年度 大阪大学基礎工学部編入学試験 [エレクトロニクスコース専門科目] 試験問題

受	験	番	号	志	望 学	科	コ	- :	7
								学	科
								-	-ス

[エレ専門-2]

問題2

熱平衡において、伝導帯中電子密度 n(x)が、位置 x (≥ 0) の関数として、

$$n(x) = N_c \exp\left(-\frac{\varepsilon_c(x) - \varepsilon_F}{k_B T}\right)$$
 (A)

と表現される半導体試料を不純物ドーピング制御により作製した.ここで、 N_c は伝導帯有効状態密度、 $\varepsilon_c(x)$ は伝導帯底エネルギー、 ε_F はフェルミ準位、 k_B はボルツマン定数で、Tは絶対温度である.以下の設問に答えよ.

(1) 半導体試料中位置 x (\geq 0) での静電ポテンシャル $\phi(x)$ と, $\varepsilon_c(x)$ とは, 位置 x=0 での静電ポテンシャルを $\phi(x)=0$ と設定し,素電荷を q としたとき,

$$-q\phi(x) = \varepsilon_c(x) - \varepsilon_c(0) \ge 0 \tag{B}$$

と関係付けられることを知って、この半導体試料のバンド図と $-q\phi(x)$ の概要を図示せよ. ただし、禁止帯幅や電子親和力は位置x によらないとする。

- (2) 半導体試料中位置 x (\geq 0) での電子の電界ドリフトによる電流密度 $J_1(x)$ を,式 (A) の伝導帯中電子密度 n(x),静電ポテンシャル $\phi(x)$,素電荷 q と電子移動度 μ_n を用いて表せ.
- (3) 半導体試料中位置x (\geq 0) での電子の拡散による電流密度 $J_2(x)$ を、伝導帯中電子密度 n(x)、静電ポテンシャル $\phi(x)$ 、素電荷 q、ボルツマン定数 k_B 、絶対温度 T と電子拡散係数 D_n を用いて表せ. なお、解答にあたっては、式 (B) を利用するとよい.
- (4) 熱平衡を想定しているため、半導体試料中のどの位置 x においても、全電子電流は 0 でなければならない。このことを踏まえて、移動度 μ_n と拡散係数 D_n の関係を示せ。また、これを用いて熱エネルギー $k_BT = 0.025$ (eV) における μ_n/D_n 比を、単位を付して求めよ。

平成26年度 大阪大学基礎工学部編入学試験
[電子システム学コース専門科目] 試験問題の注意事項

21

問題1から問題3の中から2つの問題を選択して、解答すること。

平成26年度 大阪大学基礎工学部編入学試験

電子システム学コース専門科目] 試験問題

受	験	番	号	志望学科・コース
				学 科
				コース

[電シ専門-1]

問題 1

以下の設問(1)~(3)に答えよ.

- (1) C 言語で書かれた下記のプログラム 1 は,ある整列アルゴリズム X の関数 sort である.この関数は,整列 する配列 a とその要素数 n を引数として受け取る. 関数 partition は, 適当な要素 a[v]より小さい要素を a[L]から a[v-1]に集め、a[v]よりも大きい要素を a[v+1]から a[R]に集め、v の値を返す.以下の小問 (a)~(e)に答えよ.
 - (a) 整列アルゴリズム X の名称を答えよ.
 - (b) 関数 partition 内の要素 a[v]はなんと呼ばれるか答えよ.

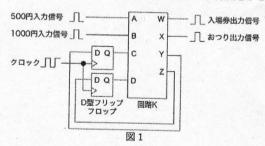
 - (c) 空欄 ア と イ を C 言語のコードで埋めよ. (d) 整列アルゴリズム X は安定な整列かどうか答えよ. なお,整列の安定性とは,整列後に,同じキーをも つデータ間で整列前の位置関係が保たれていることをいう.
 - (e) 整列アルゴリズム X とマージソートとを比較した次の文章 1 の空欄カーケを,入力データの要素数を nとしたときのオーダー表記を用いて埋めよ.

```
void sort_1(int a[], int L, int R){
   int v;
   if (L >= R) return;
   v = partition(a, L, R);
void sort(int a[], int n){
   sort_1(a, 0, n - 1);
```

プログラム1

整列アルゴリズム X, もしくは, マージソートを 配列の整列に利用することを考える. まず, 時間計 算量はいずれも [カ] である. しかしながら, 整列アルゴリズム X は,最悪計算量が [キ] で あるという欠点がある. 次に, 領域計算量を比較す ると、整列アルゴリズム X では必要となる作業領域 の大きさが [ク] であるのに対して、マージソ ートでは[ケ]である.

- (2) 1500 円の入場券を販売する自動販売機がある. 図1にその制御装置を示している. 利用者は,500 円硬貨ま たは 1000 円札を 1 クロック毎に一度だけ投入できるとし、金額が 1500 円以上になったところで入場券とお つり (必要ならば) を出すものとする. 以下の小問 $(a) \sim (c)$ に答えよ.
 - (a) 回路 K の真理値表を示せ.
 - (b) 小問 (a) の真理値表をもとにカルノー図を描き、W, X, Y, Z それぞれについて簡単化した論理式(最 小積和形表現あるいは最簡積和表現)を示せ.
 - (c) AND, OR, NOT の 3 種類の論理回路記号を用いて、回路 K の回路図を示せ、



- (3) P, Q, R, S, T が, それぞれ 1/4, 5/8, 1/16, 1/32, 1/32 の確率で生起する情報源がある. 以下の小間 (a) ~ (c) に答えよ. ただし, log25は2.3とせよ.
 - (a) この情報源のエントロピーを求めよ、ただし、エントロピーの単位はビットとする.
 - (b) ハフマン符号化を行い,符号と情報との対応を示せ.
 - (c)(b)で求めた符号の平均符号長を示せ、